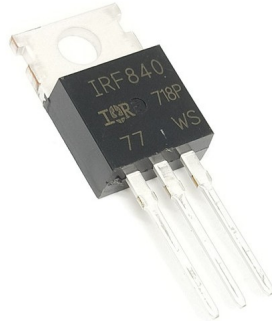


Transistor Mosfet Irf840 500 V 8 A

Codigo: **112816**

Descripción

El Irf840 es un MOSFET de potencia de N-canal de 500V, el MOSFET de potencia de tercera generación proporciona al diseñador la mejor combinación de conmutación rápida, diseño de dispositivo robusto y baja resistencia.



- Valor dinámico dV / dt

- Avalancha repetitiva
- 175 ° C Temperatura de funcionamiento
- Fácil de paralelo
- Requisito de unidad simple

Aplicaciones: Administración de potencia, industrial, dispositivos portátiles, electrónica de consumo

- Polaridad del transistor: Canal N

- Voltaje de drenaje a fuente VDS: 500 V
- Voltaje de puerta a fuente VGS: ± 20 V
- Corriente continua de drenaje ID: 8 A
- Corriente de drenaje pulsada IDP: 32 A
- Corriente de avalancha IAR: 8 A
- Disipación de potencia máxima PD (Tc=25 °C): 125 W
- Resistencia VGS RDS(on) máximo: 0.85 Ω
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 150 °C
- Encapsulado: TO-220
- Número: 3pin

Sustituto

- NTE2385 MTP8N50E